

半導体産業の「現状」と「未来」

令和4年11月に経済産業省は日本における半導体産業を活性化させるための取組として、研究開発拠点 (LSTC)、量産製造拠点(Rapidus株式会社)の立上げを発表しました。

世界から「10年遅れている」と言われている国内半導体の復活をかけた取組みが始まる中、企業や大学・研究機関はどのように行動していくべきなのでしょうか。

今回の講演では、半導体に関する研究や事業に携わっている大学・企業の立場から、半導体産業の現状、未来についてご講演いただきます。

【日時】：令和 **5** 年 **2** 月 **7** 日 (火) 14:00-17:00

【場所】：名古屋工業大学 4号館1階ホール

【スケジュール】 講演 14:00-16:20 / 事業案内 16:25-16:35 / 名刺交換会 16:40-17:00

開会挨拶

14:00-14:05

講演 1

14:05-14:45

名古屋工業大学における次世代半導体デバイスへの取り組み

青～白色のLED材料として知られるGaN系半導体は、将来の社会基盤を支える次世代の高性能半導体として今なお注目されている。本講演では、名古屋工業大学でのGaN系半導体デバイスの取組みについて紹介する。

名古屋工業大学 極微デバイス次世代材料 研究センター 教授 **三好 実人**



講演 2

14:55-15:35

深紫外 (UV-C)波長で発光するLED開発と応用製品について ～高付加価値LEDの開発～

世界的なLED低価格化を受けて、高付加価値を持ち、地球環境にやさしくCO₂削減を満たすテーマに取り組むことが日本企業に求められる。深紫外波長で発光するLED開発とその応用製品について講演する。

豊田合成株式会社 ライフソリューション事業本部 第1技術部
基幹技師 博士(工学)

齋藤 義樹



講演 3

15:45-16:25

α型酸化ガリウムパワー半導体の開発

電源や自動車などで急速に実用化が進む炭化ケイ素 (SiC) や窒化ガリウム (GaN) よりも低損失で生産コストも抑えられるとして注目を集めているα型酸化ガリウムパワー半導体の最新技術開発動向を紹介する。

株式会社FLOSFIA 取締役CSO

四戸 孝



参加費 無 料

定 員 150名

申込方法 右記の**申込フォーム**（QRコード）からお申込みください。
または、下記参加申込書に必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにてお申込みください。
※受付完了後、メール等でご連絡いたします。連絡がない場合は、
お手数ですが、お問合せください。



申込フォーム

申込期限 2023年 2月 1日（水）

申 込 先 (公財) 名古屋産業振興公社 研究推進部 研究開発支援課（担当：山本・櫛本）
お問合せ Tel: 052-736-5680 Fax: 052-736-5685
E-mail : n-ova@nipc.or.jp
URL : https://www.nipc.or.jp/sansien/nova/n_info.html

開催場所 **名古屋工業大学 4号館1階ホール**
〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町

交通手段
JR東海：中央本線 鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）
地下鉄：鶴舞線 鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）
桜通線：吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）
市バス 栄18 名大病院下車（東へ約200m）
昭和巡回 名大病院下車（東へ約200m）
<https://www.nitech.ac.jp/access/index.html>

※ FAXでお申込みの方は、切らずにこのままFAXしてください。

第14回 Nagoyaオープンイノベーション研究会 参加申込書

(公財) 名古屋産業振興公社 研究開発支援課 担当：櫛本 宛て
E-mail : n-ova@nipc.or.jp FAX : 052-736-5685

会社名	
所属・役職	
氏名	
住所	
E-mail	
Tel	

==個人情報について==
ご記入いただきました個人情報はNagoyaオープンイノベーション研究会の運営および主催者が開催するイベントのご案内に必要とされる範囲で利用させていただきます。主催者、事務局、講師以外の第三者への提供は一切行いません。保有する個人情報の開示、訂正、利用停止につきましては、n-ova@nipc.or.jpへご連絡ください。
=====